

关键指标

- 频率范围：DC~12GHz
- 隔离度：>37dB@12GHz
- 插入损耗：0.9dB
- 吸收式设计
- 纳秒级开关
- 芯片尺寸：1.24mm×1.16mm×0.1mm

典型应用

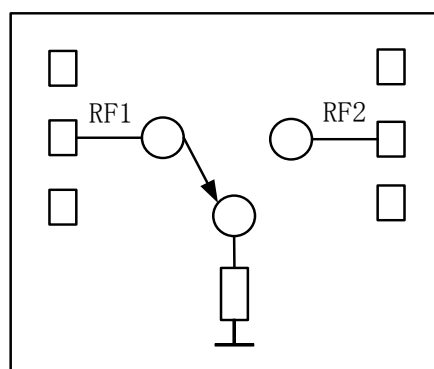
- 无线通信设备
- 雷达和电子对抗
- 军事和航天
- 仪器和仪表
- 微波无线电
- 测试和测量

产品简介

XT3207 是一款宽带吸收式砷化镓 pHEMT 单刀单掷开关芯片，输入端 50Ω 匹配，覆盖频段 DC~12GHz，芯片在整个工作频段提供大于 37dB 的隔离度和小于 1.5dB 的插入损耗。采用 0/-5V 逻辑控制，在工作频段具有优良的开关特性和端口驻波特性，适合应用于微波混合集成电路和多芯片模块以及低功耗系统。

开关芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好接地。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

功能框图



电性能 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$, 控制电平=0/-5V , 50Ω 系统)

指标	测试频率	最小值	典型值	最大值	单位
插入损耗	DC~12GHz	-	-0.9	-	dB
隔离度	DC~12GHz	-	-40	-	dB
开态回波损耗 RF1, RF2	DC~12GHz	-	-20	-	dB
关态回波损耗 RF1	DC~12GHz	-	-15	-	dB
输入 $P_{1\text{dB}}$	DC~12GHz	-	27	-	dBm
开关时间	DC~12GHz	-	5	-	ns

绝对最大额定值

射频输入功率	+27dBm	工作温度	-55℃~+85℃
控制电压范围	0~7V	贮存温度	-65℃~+150℃
静电防护等级 (HBM)	Class 1A	沟道温度	150℃

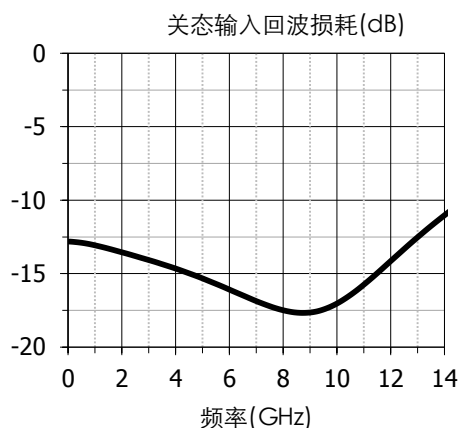
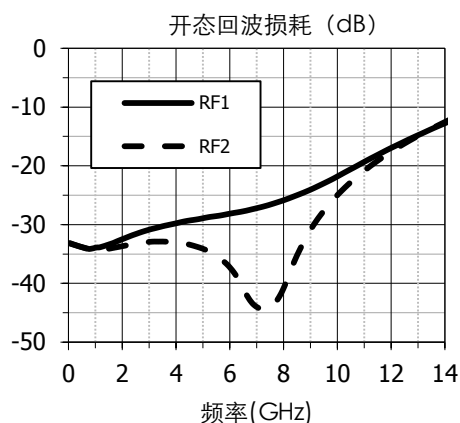
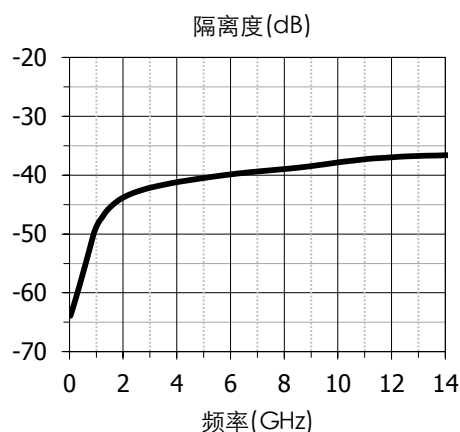
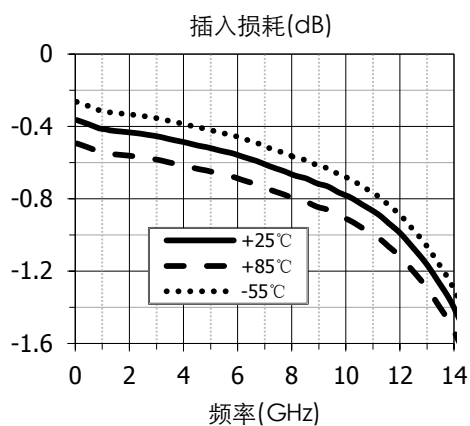
控制电压

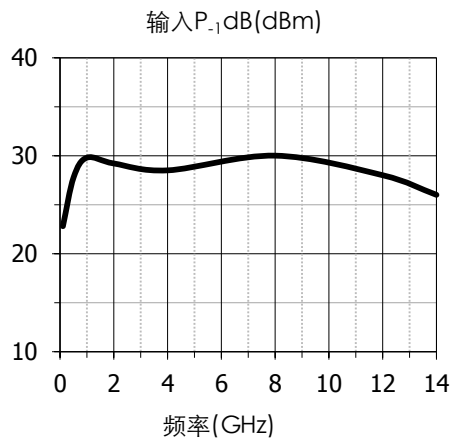
状态	偏置条件
低	0~0.2V
高	-7~-3V

真值表

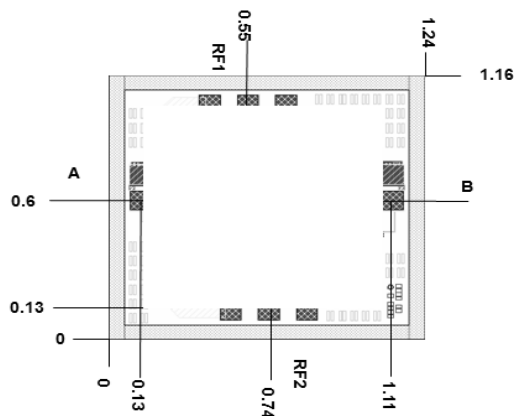
控制输入		开关状态
A	B	RF1-RF2
低	高	ON
高	低	OFF

典型测试曲线

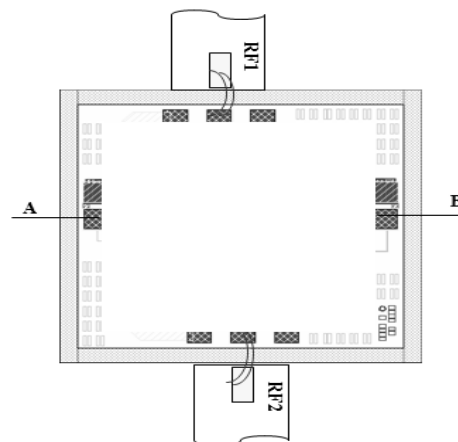




外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25 \mu m$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。